

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци бр.30/3.310-332/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор наставника за ужу научну област *Електроника и електронски системи*, у сљедећем саставу:

1. др Бранко Докић, редовни професор
Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
Ужа научна област *Електроника и електронски системи*
2. др Небојша Јанковић, редовни професор
Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Ужа научна област *Микроелектроника и микросистеми*
3. др Златко Бундало, редовни професор
Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
Ужа научна област *Електроника и електронски системи*

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА			
Пријављено:	06.09.2012.		
Орг. јед.	Број	Аргументира	Вриједност:
	897	01	

Након разматрања конкурсног материјала, у складу са Законом о високом образовању Републике Српске и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Комисија подноси сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 27.06.2012. године у дневном листу "Глас Српске"
Ужа научна/умјетничка област: Електроника и електронски системи
Назив факултета: Електротехнички факултет, Бања Лука
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Татјана (Василије) Пешић-Брђанин
Датум и мјесто рођења: 21.01.1971. године, Бијело Поље, Црна Гора
Установе у којима је био запослен:
1. Универзитет у Нишу, Електронски факултет, од 1998. год. до 2007. год.
Звања/радна мјеста: Истраживач, асистент-приправник и асистент
2. Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, од 2007. год.
Звања/радна мјеста: Доцент/наставник и продекан за наставу
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: IEEE, NEXUS

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије

Назив институције: Електронски факултет у Нишу
Мјесто и година завршетка: Ниш, 2006. год.

Постдипломске студије:

Назив институције: Електронски факултет у Нишу
Мјесто и година завршетка: Ниш, 2002. год.
Назив магистарског рада: *Физички базиран нови не-квази-стационарни модел биполарног транзистора за примене у симулаторима електричних кола*
Ужа научна/умјетничка област: *Микроелектроника*

Докторат:

Назив институције: Електронски факултет у Нишу
Мјесто и година завршетка: Ниш, 2002. год.
Назив дисертације: *Нестационарни електрични модели биполарних и MOS транзистора за примене у наноелектроници*
Ужа научна/умјетничка област: *Микроелектроника*

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Електронски факултет у Нишу, асистент-приправник, 2000-2002. год.
Електронски факултет у Нишу, асистент, 2002-2007. год.
Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, доцент, 2007-2012. год.

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

1. Радови прије последњег избора

Оригинални научни рад у часопису међународног значаја:

1. N. Janković, T. Pešić, "Modeling of Strained-Si/SiGe NMOS Transistors Including DC Self-Heating", *Solid-State Electronics*, vol. 50, pp. 496-499, 2006.
2. T. Pešić, N. Janković, "A Compact Non-Quasi-Static MOSFET Model Based on the Equivalent Non-Linear Transmission Line", *IEEE Transactions on Computer-Aided-Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 24, pp. 1550-1561, 2005.
3. N. Janković, T. Pešić, "Non-Quasi-Static Physics Based Circuit Model of Fully-Depleted Double-Gate SOI MOSFET", *Solid-State Electronics*, vol. 49, pp. 1086-1089, 2005.
4. N. Janković, T. Pešić, J. Karamarković, "1D Physical Based Non-Quasi Static BJT Circuit Model Based on the Equivalent Transmission Line Analysis", *Journal of Computational Electronics*, vol. 3, pp. 13-25, 2004.
5. T. Pešić, N. Janković, "An Analytical Model of the Inverse Base Width Modulation Effect in SiGe Graded Heterojunction Bipolar Transistors", *Microelectronics Journal*, vol.32, no. 9, pp. 713-718., 2001.

Оригинални научни рад у часопису националног значаја:

1. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "3D Numerical Simulation and the Equivalent Circuit for Electrical Modeling of Cross-shaped Hall Sensor", *Electronics*, vol. 8, No. 2, pp. 9-13, 2004.

2. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "Current Gain Frequency Characteristics of Ultra-Narrow Base Bipolar Transistors", *Electronics*, vol. 6, No. 1, pp. 30-33, 2002.

3. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "Distributed Parameters BJT Model for Arbitrary Injection Level", *Electronics*, vol. 4, No. 2, pp. 58-63, 2000.

Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини:

1. E. Jovanović, T. Pešić, N. Janković, D. Pantić, "3D Simulation and Electrical Modelling of Cross-Shaped Hall Sensor", *Digest of Technical Papers of 18th European Conference on Solid-State Sensors*, p2.50 (CD ROM), Rome, Italia, 2004.

2. E. Jovanović, T. Pešić, D. Pantić, "3D Simulation of Cross-Shaped Hall Sensor and Its Equivalent Circuit Model", *Proc. of 24th International Conference on Microelectronics - MIEL*, vol. 1, pp. 235-139, Niš, 2004.

3. T. Pešić, N. Janković, "Physical-Based Non-Quasi Static MOSFET Model For DC, AC and Transient Circuit Analysis", *Proc. of 24th International Conference on Microelectronics - MIEL*, vol. 1, pp. 261-264, Niš, 2004.

4. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "Modeling of the inverse base width modulation effect in SiGe base HBT for circuit simulation", *Proc. of IV International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM'02*, pp. 187-190, Slovakia, 2002.

5. N. Janković, T. Pešić, J. Karamarković, "1D Physically based non-quasi-static analog behavioral BJT model for SPICE", *Proc. of 23rd International Conference on Microelectronics - MIEL 2002*, vol. 2, pp. 463-468, Niš, 2002.

6. T. Pešić, J. Karamarković, N. Janković, "All injection level transmission line model of minority carrier transport", *Proc. of International Conference on Trends in Communications - EUROCON'2001*, vol. 2, pp. 412-415, Bratislava, Slovakia, 2001.

7. J.P. Karamarković, T.V. Pešić, N.D. Janković, "An Analytical Approach to Kirk Effect Modelling", *CAS 2000 Proc. - 2000 International Semiconductor Conference - 23rd Edition*, vol. 1, pp. 311-314, Sinaia, Romania, 2000.

8. T.V. Pešić, T.R. Ilić, N.D. Janković, and J.P. Karamarković, "Transient analysis of BJT using all injection level TLEC model," *Proc. of 22nd International Conference on Microelectronics - MIEL 2000*, vol. 1, pp. 149-152, Niš, Yugoslavia, 2000.

9. N.D. Janković, T.V. Pešić, and J.P. Karamarković, "Transmission line model of arbitrarily doped base including all injection levels and Kirk effect", *CAS'98 Proceedings - International Semiconductor Conference - 21st Edition*, vol. 2, pp. 383-386, Sinaia, Romania, 1998.

Научни радови на скупу националног значаја, штампани у цјелини:

1. S. Ristić, T. Pešić, "Induktivnost jednoslojnih cilindričnih kalemova", *Zbornik radova 50. konferencije za ETRAN*, sveska 4, str. 111-112, Beograd, 2006.

2. S. Ristić, D. Pantić, T. Pešić, "Izrazi za superponirane naizmenične napone i struje kod polarizovanih aluminijskih elektrolitskih kondenzatora", *Zbornik radova 49. konferencije za ETRAN*, sveska 4, str. 112-114, Budva, 2005.

3. T. Pešić, N. Janković, "Važnost primene preciznog nestacionarnog MOSFET modela za simulaciju CMOS analognih integrisanih kola", *Zbornik radova 49. konferencije za ETRAN*, sveska 4, str. 133-136, Budva, 2005.

4. T. Pešić, N. Janković, "Fizički-baziran električni model potpuno osiromašenog SOI MOSFET-a", *Zbornik radova 48. konferencije za ETRAN*, sveska 4, str. 117-120, Čačak, 2004.
5. E. Jovanović, D. Pantić, T. Pešić, B. Pešić, D. Pantić, "2D I 3D simulacija poluprovodničkih mikrokomenata korišćenjem TCAD softverskih paketa" *Zbornik radova konferencije YU INFO 2004* (CD ROM), Kopaonik, 2004.
6. T. Pešić, N. Janković, "Fizički baziran ne-kvazi-stacionarni model potpuno osiromašenog SOI MOSFET-a sa dvostrukim gejtom", *Zbornik radova konferencije INDEL 2004*, str. 24-27, Banjaluka, Republika Srpska, 2004.
7. E. Jovanović, T. Pešić, N. Janković, D. Pantić, "3D numerička simulacija i ekvivalentno kolo za električno modeliranje krstastog Holovog senzora", *Zbornik radova konferencije INDEL 2004*, str. 20-23, Banjaluka, Republika Srpska, 2004.
8. T. Pešić, S. Ristić, "Generalizovan Selvakumarov izraz za veliku gustinu struje manjinskih nosilaca", *Zbornik radova 47. konferencije za ETRAN*, sveska 4, str. 104-106, Herceg Novi, 2003.
9. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "Frekventna karakteristika strujnog pojačanja bipolarnih tranzistora sa ultra-uskim bazama", *Zbornik radova 46. konferencije ETRAN*, sveska 4, str. 134-137, Banja Vrućica, 2002.
10. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "Modelovanje efekta modulacije širine baze SiGe heterospojnih bipolarnih tranzistora za primene u simulatorima električnih kola", *Zbornik radova konferencije INDEL 2002*, str. 28-31, Banjaluka, Republika Srpska, 2002.
11. E. Jovanović, D. Pantić, T. Pešić, D. Pantić, "Karakteristike VDMOS tranzistora sa super-spojem", *Zbornik radova konferencije INDEL 2002*, str. 22-24, Banjaluka, Republika Srpska, 2002.
12. T. Pešić, N. Janković, J. Karamarković, "Faktor idealnosti kolektorske struje kod heterospojnih bipolarnih tranzistora sa gradiranom Si1-xGex bazom", *Zbornik radova 45. konferencije ETRAN*, sveska 4, str. 196-199, Bukovička Banja, 2001.
13. T. Pešić, J. Karamarković, N. Janković, "Analitički pristup Kirkovom efektu za primenu u modelovanju bipolarnih tranzistora", *Zbornik radova 44. konferencije ETRAN*, sveska 4, str. 189-192, Sokobanja, 2000.
14. T. Pešić, J. Karamarković, N. Janković, "Model bipolarnog tranzistora sa raspodeljenim parametrima za proizvoljne nivoe injekcije", *Zbornik radova konferencije INDEL 2000*, str. 166-171, Banjaluka, Republika Srpska, 2000.
15. T. Pešić, J. Karamarković, N. Janković, "Modelovanje Kirkovog efekta kod nelinearnog nehomogenog voda sa gubicima pri proizvoljnim nivoima injekcije", *Zbornik radova 43. konferencije ETRAN*, sveska 4, str. 154-157, Zlatibor, 1999.
16. N.D. Janković, T.V. Pešić, J.P. Karamarković, "Model ekvivalentnog voda za transport manjinskih nosilaca pri proizvoljnim nivoima injekcije", *Zbornik radova 42. konferencije ETRAN*, sveska 4, str. 56-59, Vrnjačka Banja, 1998.
17. N.D. Janković, T.V. Pešić, T.R. Ilić, J.P. Karamarković, "Uticaj baznih kvazi-balističkih efekata na električne karakteristike bipolarnih tranzistora", *Zbornik radova 41. konferencije ETRAN*, sveska 4, str. 57-60, Zlatibor, 1997.

2. Радови послје последњег избора

Оригинални научни рад у часопису међународног значаја:

1. N. Janković, T. Pešić, D. Pantić, "Dynamic MAGFET Model for Sensor Simulations", *IET Circuits, Devices & Systems (formerly IEE Proceedings Circuits, Devices & Systems)*, vol. 1, pp. 270-274, 2007.

Нови модел MOSFET транзистора са подијељеним дрејном, који је магнетно осјетљив (MAGFET), описан је у овом раду. Модел се састоји од два n-канална MOS транзистора у еквивалентном потколу. Развијен је на основу нестационарног MOS модела конвенционалне MOSFET структуре, који је модификован тако да укључи ефекте Лоренцове силе. На бази резултата 3-D нумеричке симулације, показано је да нови модел може тачно предвидјети апсолутну и релативну осјетљивост MAGFETа за широк опсег поларизација. За разлику од осталих модела, нови MAGFET модел може такође тачно предвидјети динамички одзив на временски промјенљиво магнетско поље.

(8 бодова)

2. N. Janković, T. Pešić, P. Igić, "All Injection Level Power PiN Diode Model Including Temperature Dependence", *Solid-State Electronics*, vol. 51, pp. 719-725, 2007.

У овом раду је развијен нови модел снажне PiN диоде, који се заснива на генерализованој дрифт-дифузионој теорији за транспорт мањинских носилаца наелектрисања при свим нивоима инјекције. Дефинисани су еквивалентни водови са губицима којима се описује транспорт носилаца кроз произвољно допиране квази-неутралне базне и емиторске области. Проширени електротермички модел диоде који укључује температурне зависности параметара транспорта је такође описан и уграђен у симулатор кола PSPICE. Одлично слагање резултата модела са нумеричком симулацијом реалне снажне PiN диоде добијено је за различите услове прекидања и температуре, подешавањем малог броја параметара модела.

(8 бодова)

Оригинални научни рад у часопису националног значаја:

1. T. Pešić-Brdjanin, N. Janković, "Strained Si/SiGe MOS transistor model", *Electronics*, vol. 13, pp. 18-22, 2009.

У раду је описан модел хетероспојног Si/SiGe MOS транзистора који је развијен на основу модела расподеле површинског потенцијала. Модел је изведен модификацијом модела стандардног MOSFETа на начин да укључе транспортне параметре и параметре материјала за слојеве напрегнутог силицијума и релаксираног SiGe. Развијени модел је уграђен у симулатор кола и резултати модела су верификовани поређењем са експерименталним резултатима.

(5 бодова)

Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини:

1. B. Dokić, T. Pešić-Brdjanin, A. Pajkanović, „Full-swing Low Voltage BiCMOS/CMOS Schmitt Trigger“, *Proceedings of Small Systems Simulation Symposium*, pp. 54-57, Niš, 2012.

У раду је описан нисконапонски Шмитов тригер који обезбјеђује пуну логичку амплитуду у оба смјера. Предложена рјешења имају два комплементарна излаза, инвертујући (BiCMOS) и неинвертујући (CMOS). Предложени математички модел за одређивање напона прага потврђен је симулацијом. Напонски хистерезис зависи од напона напајања, напона прагова MOS транзистора и односа геометрије улазних MOS и транзистора унутар позитивне повратне спреге. Како се овај однос мијења од 0.3 до 2, то се напонски хистерезис мијења од $0.2V_{DD}$ до $0.54V_{DD}$.

(6 бодова)

2. J. Galić, T. Pešić-Brđanin, „The Voice Fundamental Frequency Statistical Parameters under Noisy Conditions with the Cepstrum Method“, *10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIS 2011*, pp. 769-772, Niš, 2011.

У овом раду је анализиран утицај бијелог шума на статистичке параметре основне фреквенције говорног сигнала. Основна фреквенција говорног сигнала је одређена помоћу софтвера, употребом кепстралног метода. Показано је да се модификација може користити као добар естиматор основне фреквенције говорног сигнала.

(6 бодова)

3. T. Pešić-Brđanin, N. Janković, D. Pantić, “SPICE MAGFET Model and Its Application for Simulation of Magnetically Controlled Oscillator“, *Proc. of 26th International Conference on Microelectronics - MIEL*, vol. 2, pp. 503-506, Niš, 2008.

У раду је дат модел MAGFETа, који је раније развијен и описан. Модел је развијен и за стационарна и временски промјенљива магнетска поља. Примјена модела је дата кроз симулацију магнетно контролисаног осцилатора, чија је излазна фреквенција линеарна функција амплитуде магнетске индукције примијењеног магнетског поља. Добијени резултати су у сагласности са експерименталним резултатима преузетим из литературе.

(6 бодова)

4. N. Janković, T. Pešić, D. Pantić, “Spice Model of Magnetic Sensitive MOSFET“, *Proc. of XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST*, vol. 2, pp. 653-656, Ohrid, Macedonia, 2007.

Развијен је електрични модел MOSFET транзистора који је осјетљив на промјене магнетског поља. Рад MAGFETа подијељеним дрејном апроксимиран је спојем два идентична MOS транзистора која раде у паралели. Показано је како се транспорт носилаца у каналу ова два транзистора може описати RC водовима, при чему се отпорност R у воду мијења са примијењеним магнетским пољем индукције B_z која је нормална на раван структуре. Резултати модела су верификовани поређењем са резултатима нумеричке симулације.

(6 бодова)

Научни радови на скупу националног значаја, штампани у цјелини:

1. V. Paunović, V. Mitić, Lj. Živković, T. Pešić-Brđanin, „Mikrostruktura i dielektrična svojstva donor-akceptor (NbMn) kodopirane BaTiO₃ keramike“, rad prezentovan na *56. konferenciji za ETRAN*, MN, Zlatibor, 2012.

U ovom radu ispitivane su mikrostrukturne i dielektrične karakteristike Nb/Mn kodopirane BaTiO₃ keramike sintetizovane polazeći od prahova dobijenih Pechini metodom. Za 0.4Nb-0.05Mn kodopiranu BaTiO₃ keramiku sintetizovanu na 1310 °C karakteristična je bimodalna struktura sa veličinom zrna od 10 do 30 μm i od 1 do 5 μm. Na temperaturi od 1330 °C, nezavisno od koncentracije Mn, dobija se uniformna mikrostruktura sa veličinom zrna do 6 μm. Najveću vrednost dielektrične konstante na sobnoj temperaturi i najveću promenu dielektrične konstante sa promenom temperature pokazuje 0.4Nb-0.01Mn dopirana keramika. Dielektrična konstanta za sve ispitivane uzorke postiže konstantnu vrednost za frekvencije veće od 3 kHz. Kirijeva temperatura svih uzoraka pomerena je ka nižim vrednostima u odnosu na nedopiranu BaTiO₃ keramiku. Kirijeva konstanta C i Kirijeva temperatura T_c izračunate su koristeći Kiri-Vajsov zakon.

(3 бода)

2. J. Galić, T. Pešić-Brđanin, "Uporedna analiza metoda za estimaciju osnovne frekvencije govornog signala u prisustvu bijelog šuma", *Zbornik radova 55. konferencije za ETRAN, AK2.1-1-4m, Banja Vrućica, Republika Srpska, 2011.*

U radu je prikazana uporedna analiza metoda za određivanje osnovne frekvencije govornog signala. Urađeno je određivanje osnovne frekvencije autokorelacionom metodom i kroskorelacionom metodom pomoću programskog paketa za obradu govornog signala PRAAT. Određivanje osnovne frekvencije govornog signala je urađeno i pomoću keprstralne metode, gdje se za određivanje maksimuma keprstralne funkcije koristio programski paket MATLAB. Pokazano je kako bijeli šum utiče na određivanje osnovne frekvencije govornog signala, odnosno na njegove statističke parametre, u slučaju sve tri metode određivanja osnovne frekvencije, i za signale koji su dobijeni u slučaju govornika muškog i ženskog pola.

(3 бода)

3. J. Galić, T. Pešić-Brđanin, I. Janković, "Statistička analiza osnovne frekvencije kod vokala srpskog jezika", *Zbornik radova konferencije INDEL 2010, str. 236-239, Banjaluka, Republika Srpska, 2010.*

У раду је анализирана статистичка расподела основне фреквенције гласа за вокале (самогласнике) српског језика. За узорак је коришћена снимљена база гласова особа мушког пола. На основу одређених основних фреквенција за све вокале свих говорника, израчунати су статистички параметри основне фреквенције гласа. Тестирана је хипотеза о сагласности расподелеосновне фреквенције са нормалном и нормално-логаритамском расподелом. Урађена је апроксимација хистограмске расподеле основне фреквенције нормалном Гаусовом расподелом.

(3 бода)

4. T. Pešić, N. Janković, "Model heterospojnog Si/SiGe MOS tranzistora sa napregnutim kanalom", *Zbornik radova konferencije INDEL 2008, str. 24-28, Banjaluka, Republika Srpska, 2008.*

У овом раду је описан нови модел хетероспојног Si/SiGe MOS транзистора који је развијен на бази раније описаног нестационарног модела конвенционалног MOSFETA. Основне једначине нестационарног модела MOSFETA су модификоване тако да укључе нове физичке параметре слојева напрегнути силицијум и релаксирани SiGe. Поређењем резултата модела са експерименталним подацима, показано је да модификовани NS MOS модел, који укључује и ефекат самозагревања, може тачно предвидети dc карактеристике хетероспојног MOS транзистора са напрегнутим каналом.

(3 бода)

3. Књиге прије последњег избора

1. Д. Панћић, Т. Пешић, Е. Јовановић, *Моделирање и симулација у микроелектроници*, Електронски факултет у Нишу и WUS Austria, 2005. год.

4. Књиге послје последњег избора

1. Б. Л. Докић, Т. Пешић-Брђанин, *Линеарна интегрисана кола*, Електротехнички факултет Бања Лука и Академска мисао Београд, 2012. год.

(10 бодова)

Укупан број бодова

(63 бода)

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора

Татјана Пешић-Брђанин је као асистент-приправник и асистент на Електронском факултету у Нишу учествовала у реализацији и извођењу аудиторних и лабораторијских вјежби из предмета *Електронске компоненте, Основи микроелектронике, Микроелектроника, Полупроводничке компоненте, Моделирање и симулација, Микроелектронске технологије и Физичка електроника.*

2. Образовна дјелатност после посљедњег избора

Као доцент, на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци изводила је наставу из следећих предмета: *Основи електротехнике 1, Основи електротехнике 2, Теорија електричних кола 1, Телекомуникациона електроника.* На Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци изводила је наставу из предмета *Електроника.* На Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци изводила је наставу из предмета *Електротехника и технологија 1 и Електротехника и технологија 2.*

Учествовала је у комисијама за одбрану магистарских теза и завршних радова II циклуса студија. Била је ментор студентима за израду дипломских радова.

Квалитет педагошког рада на Универзитету

(4 бода)

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије посљедњег избора

1. Физика, моделовање и карактеризација диелектричних слојева за MOS наноконпоненте, 2000-2005, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије и ЕИ Холдинг Ниш
2. Физика, моделовање и карактеризација појава у танким слојевима код MOS наноконпонената, 2006-2010, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије и ЕИ Холдинг Ниш
3. Мобилна аутоматизована платформа за откривање и просторно мапирање дејства јонизујућих извора зрачења; 2005-2006, Институт 1. мај Ниш и Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије
4. ЕЛДИ соларни систем за расвету (Пројектовање, изградња, мониторинг и демонстрација фотонапонског система за снабдевање пословног објекта електричном енергијом за осветљење), д.о.о. ЕЛДИ, Ниш и Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије

2. Стручна дјелатност после посљедњег избора

1. Развој електричних модела наноелектронских конпонената, 2008/2009, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

2. Корекција перцепције звука код дјеце са оштећењем слуха, 2008/2009, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

3. Пројектовање дигиталних електронских кола и система који користе више логичких нивоа, 2008/2009, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

4. Имплементација и тестирање EtherCat система, 2008/2009, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

5. Пројектовање индивидуалних електронских система за побољшање слуха, 2009/2010, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

6. Синтеза и оптимизација дигиталних електронских кола и система код којих се користи више логичких стања, 2009/2010, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

7. Истаживање, пројектовање и примјена микропроцесорски управљаних система за побољшање енергетске ефикасности у интелигентним грађевинским објектима, 2010/2011, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

8. Развој и имплементација микропроцесорски управљаних система LED расвјете и LED система за сигнализацију и информисање, 2010/2011, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

9. ERASMUS MUNDUS, Eeuroweb – European Reasearch and Education Collaboration with Western Balkan, 2011/2014, Commission of European Communities

(4 бода)

10. Побољшање енергетске ефикасности код карактеристичних типова потрошача у Републици Српској, 2011/2012, Министарство за науку и технологију Републике Српске

(4 бода)

11. NORBOTECH - NORwegian-BOsnian TECHnology Transfer based on Sustainable Systems Engineering and Embedded Systems in the fields of Cloud Computing and Digital Signal Processing, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

(4 бода)

Укупан број бодова

(44 бода)

Укупан број бодова (3+4+5)

(111 бодова)

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу увида у Конкурсни материјал и податке који су дати у Извјештају, Комисија је закључила да кандидат, доцент др Татјана Пешић-Брђанин, дипломирани инжењер електронике, задовољава све услове прописане Законом о високом образовању

Републике Српске (чланови 74-78) и Статутом Универзитета (члан 135) за избор у звање **ванредни професор** за ужу научну област *Електроника и електронски системи*.

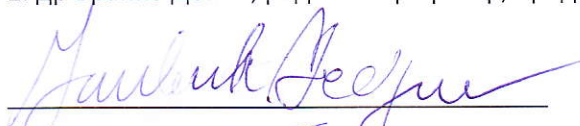
На основу свега изнесеног у овом Извјештају, Комисија са задовољством предлаже Научно-наставном вијећу Електротехничког факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се кандидат, доц. др Татјана Ђешић-Брђанин, изабере у звање **ванредни професор** за ужу научну област *Електроника и електронски системи* на Универзитету у Бањој Луци.

Бања Лука, Ниш, август 2012. Године

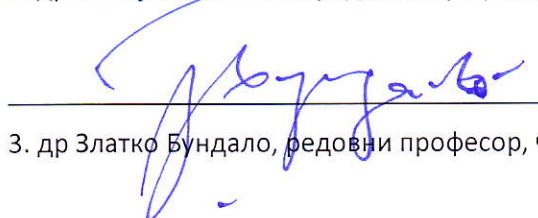
КОМИСИЈА:



1. др Бранко Докић, редовни професор, предсједник



2. др Небојша Јанковић, редовни професор, члан



3. др Златко Бундало, редовни професор, члан